

160

PTO/SB/21 (09-04) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031

TINAD					U.S. F	Patent and Tr	ademark Office;	through 07/31/2006. OMB 0651-0031 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995. no persons  TRANSMITTAL  FORM			Application Number Filing Date First Named Inver	nd to a col er	10/711 10/19/	1,997		
(to be used for all correspondence after initial filing)  Total Number of Pages in This Submission 3			Examiner Name  Attorney Docket N		TMIP00			
Fee Transmittal Form  Fee Attached  Amendment/Reply  After Final  Affidavits/declaration(s)  Extension of Time Request  Express Abandonment Request		Orawing(s)  Licensing-related Parametric Petition Petition to Convert to Provisional Application of Attorney, Recover of Attorney, Power of Correspondent Perminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(standscape Tables	o a on Revocation ndence A	After Allowance Communication to  Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences  Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter  Other Enclosure(s) (please Identify below):		al Communication to Board peals and Interferences al Communication to TC al Notice, Brief, Reply Brief) ietary Information s Letter Enclosure(s) (please Identify		
Firm Name	North /	SIGNA America Intelle		F APPLICANT,	ATTO	RNEY, O	R AGENT	
Signature		unton !		1 2 F.				
Printed name Winston Hsu								
Date   11/17/2004   Reg. No.								
CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING  I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on								
the date shown be Signature								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Typed or printed name							Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

NOV 1 8 2004 BY TENT & TRACE THE Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond

PTO/SB/17 (10-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

# FEE TRANSMITTAL for FY 2005

Effective 10/01/2004. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT** 

(\$) 0.00

Complete if Known			
Application Number	10/711,997		
Filing Date	10/19/2004		
First Named Inventor	Shih-Feng Shao		
Examiner Name			
Art Unit			
Attorney Docket No.	TMIP0005USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)  FEE CALCULATION (continued)	FEE CALCULATION (continued)				
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES	3. ADDITIONAL FEES				
Deposit Account:					
Fee Fee Fee Fee Fee Fee Description	Fee Paid				
Account Number 50-3105 1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath	Tee Taile				
Deposit North America Intellectual Property Corp. 1052 50 2052 25 Surcharge - late provisional filling fee or					
Name Cover sneet					
The Director is authorized to: (check all that apply)	ition				
[7] Change any additional (a) or any understandary of to (a) 1804 920* 1804 920* Requesting publication of SIR prior to					
Examiner action					
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.  1805 1,840* Requesting publication of SIR after Examiner action					
FEE CALCULATION 1251 110 2251 55 Extension for reply within first month					
1. BASIC FILING FEE 1252 430 2252 215 Extension for reply within second month					
Large Entity Small Entity 1253 980 2253 490 Extension for reply within third month					
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid 1254 1,530 2254 765 Extension for reply within fourth month					
1001 790 2001 395 Utility filing fee 1255 2,080 2255 1,040 Extension for reply within fifth month					
1002 350 2002 175 Design filing fee 1401 340 2401 170 Notice of Appeal					
1003 550 2003 275 Plant filing fee 1402 340 2402 170 Filing a brief in support of an appeal					
1004 790 2004 395 Reissue filing fee 1403 300 2403 150 Request for oral hearing					
1005 160 2005 80 Provisional filing fee 1451 1,510 1451 1,510 Petition to institute a public use proceed	ng				
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00   1452 110   2452 55 Petition to revive - unavoidable	$\vdash$				
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE					
Fee from 1501 1,370 2501 665 Utility issue lee (or reissue)					
Extra Claims below Fee Paid 1502 490 2502 245 Design issue fee  Total Claims -20** = X 1503 660 2503 330 Plant issue fee					
Independent 3**   1903 660 2503 330 Plant Issue fee					
Claims 1460 130 Petitions to the Commissioner Multiple Dependent 1807 50 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)					
Large Entity   Small Entity   1806   180   1806   180   Submission of Information Disclosure St	nt l				
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$)	···				
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20					
1809 790 2809 395 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))					
1203 300 2203 150 Multiple dependent claim, if not paid 1810 790 2810 395 For each additional invention to be					
1204 88 2204 44 ** Reissue independent claims examined (37 CFR 1.129(b))					
over original patent 1801 790 2801 395 Request for Continued Examination (Re	(E)				
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent 1802 900 1802 900 Request for expedited examination of a design application					
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00 Other fee (specify)	Other fee (specify)				
*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$)	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00				

SUBMITTED BY				(Complete (	if applicable))
Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	302-729-1562
Signature	Weintentais	-		Date	11/17/2004

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



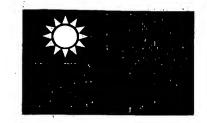
PTO/SB/02B (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
a a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number

#### **DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet**

Foreign applications:					
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attack	hed? NO
093123843	Taiwan R.O.C.	8/9/2004		V	
		·			
					_
					$\overline{}$
					_
					<u> </u>
					$\exists$
					<u> </u>
				<u> </u>	

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



#### एड एड एड एड



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

인도 인도 인도 인도 인도 인도 인도 인도 인도 인도

인도 인도 인도 인도

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 <u>2004</u> 年 <u>08</u> 月 <u>09</u> 日 Application Date

申)請案號: 093123843 **CERTIFIED COPY OF** Application No. **PRIORITY DOCUMENT** 

申 請 人:探微科技股份有限公司 (Applicant(s)

局 長 Director General

為 续 4

發文日期: 西元 2004 年 8 月 1 Issue Date

發文字號: 09320777800

Serial No.

# 發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字,請勿任意更動,※記號部分請勿填寫)

※申請案號:

※申請日期:

※IPC 分類:

一、發明名稱:(中文/英文)

晶圓切割之方法 /

METHOD OF SEGMENTING A WAFER

#### 二、申請人:(共1人)

姓名或名稱:(中文/英文)

探微科技股份有限公司 /

TOUCH MICRO-SYSTEM TECHNOLOGY INC

代表人:(中文/英文)

李家弘 / LEE, XAVIER C.H.

住居所或營業所地址:(中文/英文)

桃園縣楊梅鎮高山里高獅路五六六號 / No. 566, Gaoshih Rd., Yangmei Township, Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.

國 籍:(中文/英文)

中華民國 / TWN

#### 三、發明人:(共3人)

姓 名:(中文/英文)

- 1. 邵世豐 / SHAO, SHIH-FENG
- 2. 楊辰雄 / YANG, CHEN-HSIUNG
- 3. 彭新亞 / PENG, XSIN-YA

國 籍:(中文/英文)

- 1. 中華民國 / TWN
- 2. 中華民國 / TWN
- 3. 中華民國 / TWN

四、聲明事項:
□ 主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實,其
事實發生日期為: 年 月 日。
○ 申請前已向下列國家(地區)申請專利:
【格式請依:受理國家(地區)、申請日、申請案號 順序註記】
<b>有主張專利法第二十七條第一項國際優先權:</b>
□ 無主張專利法第二十七條第一項國際優先權:
□ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權:
□ 主張專利法第三十條生物材料:
□ 須寄存生物材料者:
國內生物材料 【格式請依:寄存機構、日期、號碼 順序註記】
國外生物材料 【格式請依:寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】
□ 不須寄存生物材料者:
所屬技術領域中目右通党知識老易於獲得時,不須客在。

### 五、中文發明摘要:

首先提供一晶圓,該晶圓係利用一支撐載具承載,且該 支撐載具與該晶圓之間依序包含有一黏著層與一擴張膜。 接著於該晶圓之一表面形成一光阻圖案,以定義出該晶圓 之切割道。隨後進行一非等向蝕刻製程,去除未被該光阻 圖案覆蓋之該晶圓,以形成複數個晶粒。最後分離該黏著 層與該支撐載具。

#### 六、英文發明摘要:

A wafer substrate is provided. The wafer substrate is bonding to a supporting carrier with a bonding layer and an expansion film. Then, a photoresist pattern is formed on the wafer substrate surface to define scribe lines, and an anisotropic etching process is performed to remove the wafer substrate not covered by the photoresist pattern so as to form a plurality of dies. Finally, the supporting carrier and the bonding layer are separated.

## 七、指定代表圖:

- (一)本案指定代表圖為:第(7)圖。
- (二)本代表圖之元件符號簡單說明:
- 50 支撐載具 52 黏著層
- 54 擴張膜 56 晶圓
- 60 晶粒

八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:

無

### 九、發明說明:

#### 【發明所屬之技術領域】

本發明係關於一種晶圓切割之方法,尤指一種於切割完 畢後能直接進行自動擴片與撿晶之晶圓切割的方法。

#### 【先前技術】

當晶圓經歷了數十至數百道半導體製程而製作出複數個呈陣列排列之積體電路或微機電結構後,即會利用切割製程將晶圓切割出複數個晶粒(die),以便進行後續之封裝製程,進而製作出可與電路板電連接之晶片(chip)。

請參考第1圖,第1圖為一習知利用切割機台進行切割製程之方法示意圖。如第1圖所示,欲進行切割製程之一晶圓10係貼附於一黏著層12上,例如一膠帶,而黏著層12係同時黏著於一支撐框架14上,藉此固定晶圓10之位置。當切割機台完成晶圓10之對位後即會利用切割刀16,依照預先設定好之切割道(scribe line),將晶圓10切割成複數個晶粒18。其中在形成複數個晶粒18後則可視切割道之線寬進行一擴片製程,亦即利用拉伸黏著層12使晶粒18之間距擴大,以利進行後續之撿晶製程。

上述利用切割機台之切割刀 16 進行切割製程之方式, 為目前最廣泛使用之切割方式,然而由於切割刀 16 具有一定之寬度,在半導體製程之線寬逐漸下降,利用切割刀 16 之切割製程已無法應用於高積集度之晶圓的切割製程,而 且當晶圓表面配置的晶粒數目過多時,這種利用切割刀 16 進行切割製程的方式,更嚴重降低產能(throughput)。因此 利用蝕刻方式進行切割製程之方法便成為另一種選擇。

請參考第2圖,第2圖為一習知利用蝕刻方式進行切割製程之方法示意圖。如第2圖所示,首先,一欲進行切割製程之晶圓30係利用一黏著層32貼附於一支撐載具34上,同時晶圓30之表面並包含有一光阻圖案36,用以定義切割道圖案。接著進行一非等向性蝕刻製程,去除未被光阻圖案36覆蓋之晶圓30直至蝕穿晶圓30,即可形成複數個晶粒38。

習知技藝利用蝕刻方式進行切割製程固然可以降低切割道之線寬,增加晶圓 30 表面的晶粒配置數目,然而在切割道之線寬變窄的情況下,在進行完切割製程後,往往無法順利地進行後續之撿晶製程。因為支撐載具 34 係為一剛

性物體,例如一支撐晶圓,因此無法利用前述之擴片製程,直接利用拉伸黏著層 32 的方式使晶粒 38 之間距加大。在此情況下,目前習知的作法係將晶粒 38 表面之光阻圖案 36 去除,並將黏著層 32 去除以分離晶粒 38 與支撐載具 34 後,再採用人工方式進行撿晶製程,如此一來將嚴重影響產能,並可能因人為因素造成晶粒 38 受損而使良率下降。

有鑑於此,申請人擬提供一種晶圓切割之方法,可適用 於切割以及後續之自動擴片與撿晶製程,以達到生產自動 化之目的,進而提高產能與良率。

#### 【發明內容】

因此,本發明之主要目的在提供一種晶圓切割之方法, 以克服習知技術無法解決之難題。

根據本發明之一較佳實施例,係提供一種晶圓切割之方法。首先提供一晶圓,該晶圓係利用一支撐載具承載,且該支撐載具與該晶圓之間依序包含有一黏著層與一擴張膜。接著於該晶圓之一表面形成一光阻圖案,以定義出該晶圓之切割道。隨後進行一非等向蝕刻製程,去除未被該光阻圖案覆蓋之該晶圓,以形成複數個晶粒。最後分離該

黏著層與該支撐載具。

由於本發明晶圓切割之方法係利用一黏著層與一擴張 膜接合晶圓與支撐載具,在完成切割製程而形成複數個晶 粒後,再利用不傷害擴張膜之方式,如加熱或照光,分離 擴張膜與支撐載具。因此當擴張膜與無法擴張之支撐載具 分離後,便可直接進行一自動擴片製程來增加晶粒之間 距,以利後續撿晶與焊晶製程。

為了使 貴審查委員能更近一步了解本發明之特徵及 技術內容,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖。然 而所附圖式僅供參考與輔助說明用,並非用來對本發明加 以限制者。

#### 【實施方式】

請參考第3圖至第8圖,第3圖至第8圖為本發明一較 佳實施例進行切割製程之方法示意圖。如第3圖所示,首 先提供一支撐載具50,如一空白晶圓,並於支撐載具50 之表面依序形成一黏著層52與一擴張膜54,其中擴張膜 54為一可擴張並具有黏性之薄膜,例如一塑性材質之薄 膜,黏著層52則為一熱分離膠帶或一紫外線膠帶等可利用 加熱或照射紫外線等方式加以去除之膠帶,或為其他具黏性且於去除過程中不會影響擴張膜 54 之黏性的材質。如第4 圖所示,接著將一晶圓 56 貼附並固定於擴張膜 54 之表面。

如第5圖所示,接著於晶圓56之表面塗佈一光阻層(圖未示),並利用曝光暨顯影製程形成一光阻圖案58,用以於晶圓56之表面定義出切割道圖案。然後如第6圖所示,進行一非等向蝕刻製程,例如一乾式蝕刻,蝕刻未被光阻圖案58覆蓋之晶圓56直至蝕穿晶圓56之底部,以形成複數個晶粒60,最後再將光阻圖案58去除。

隨後如第7圖所示,去除黏著層 52 使擴張膜 54 與支撐 載具 50 分離。其中分離擴張膜 54 與支撐載具 50 之步驟需 視黏著層 52 之特性而採用不同之方式,例如若使用熱分離 膠帶作為黏著層 52,則可利用加熱方式來分離擴張膜 54 與支撐載具 50,且值得注意的是擴張膜 54 之熔點必須高 於黏著層 52 之熔點,以避免因溫度過高造成擴張膜 54 喪 失其黏性,而使擴張膜 54 表面之晶粒 60 脫落。另外,若 使用紫外線膠帶作為黏著層 52,則可利用照射紫外線方式 使黏著層 52 喪失其黏性,以分離擴張膜 54 與支撐載具 50。 如第8圖所示,在擴張膜54已脫離支撐載具50的情況下,由於擴張膜54具有可拉伸之特性,因此可直接進行一自動擴片製程,亦即利用拉伸擴張膜54使晶粒60之間距加大,以利於後續進行自動撿晶製程與焊晶製程,進而完成晶粒60之封裝製程。

由上述可知,由於本發明晶圓切割之方法係利用一黏著層與一擴張膜接合晶圓與支撐載具,在完成切割製程而形成複數個晶粒後,便可利用加熱或照光等並不傷害擴張膜之方式分離擴張膜與支撐載具。當擴張膜與無法擴張之支撐載具分離後,由於擴張膜具有可拉伸之特性,因此可直接進行一自動擴片製程以增加晶粒之間距,以利後續撿晶與焊晶製程。

相較於習知技術,本發明晶圓切割之方法由於利用非等 向性蝕刻方式進行切割製程,不僅可達到較精細之切割道 線寬,以增加晶粒的配置數目,同時於切割製程完成後更 可直接進行自動擴片製程與自動化撿晶製程。反觀習知技 術於利用蝕刻方式進行完切割製程後,並無法進行擴片製 程,而必須仰賴人工方式撿晶,大幅影響製程時間及生產 良率。因此,本發明晶圓切割之方法可有效提升產能,並減少人工撿晶造成晶粒受損之風險。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。

#### 【圖式簡單說明】

- 第 1 圖為一習知利用切割機台進行切割製程之方法示意 圖。
- 第2圖為一習知利用蝕刻方式進行切割製程之方法示意 圖。
- 第3圖至第8圖為本發明一較佳實施例進行切割製程之 方法示意圖。

#### 【主要元件符號說明】

10	晶圓	12	黏著層
14	支撐框架	16	切割刀
18	晶粒	30	品圓
32	黏著層	34	支撐載具
36	光阻圖案	38	晶粒
50	支撐載具	52	黏著層

54擴張膜56晶圓58光阻圖案60晶粒

### 十、申請專利範圍:

1. 一種晶圓切割之方法,其包含有:

提供一支撐載具,且該支撐載具之一上表面依序包含有一黏著層與一擴張膜;

提供一晶圓,並將該晶圓之一底表面貼附於該擴張膜上;

進行一切割製程,將該晶圓切割成複數個晶粒;以及分離該擴張膜與該支撐載具。

- 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該黏著層係為 一熱分離膠帶。
- 3. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中分離該擴張膜 與該支撐載具係利用加熱方式達成。
- 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該擴張膜係為 一具擴張性之膠帶,且該膠帶之熔點大於該熱分離膠帶 之熔點。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該黏著層係為 一紫外線膠。

- 6. 如申請專利範圍第 5 項所述之方法,其中分離該擴張膜 與該支撐載具係利用照射紫外線方式達成。
- 7. 如申請專利範圍第 6 項所述之方法,其中該擴張膜係為 一具擴張性之膠帶。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該切割製程包含有:

於該晶圓之一上表面形成一光阻圖案,用以定義該晶圓之切割道;

進行一非等向蝕刻製程,去除未被該光阻圖案覆蓋之該 晶圓。

- 9. 如申請專利範圍第8項所述之方法,另包含於該切割製程完成後進行一去除該光阻圖案之步驟。
- 10.如申請專利範圍第1項所述之方法,另包含於分離該擴張與該支撐載具後進行一擴片暨撿晶製程。
- 11.一種晶圓切割之方法,其包含有:

提供一晶圓,該晶圓係利用一支撐載具承載,且該支撐載具與該晶圓之間依序包含有一黏著層與一擴張膜;

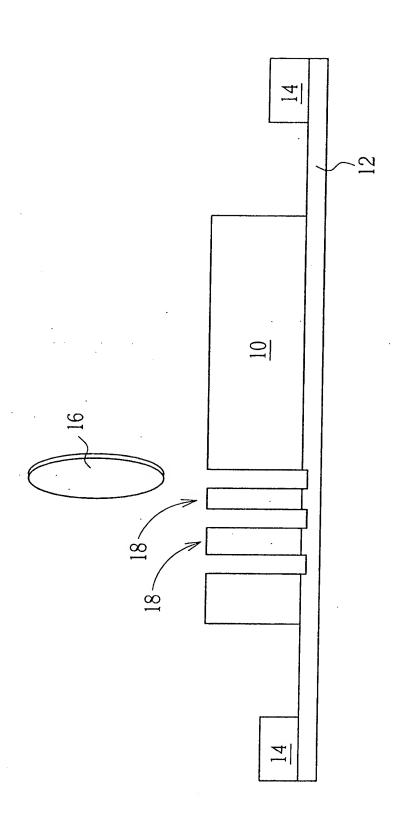
於該晶圓之一表面形成一光阻圖案,以定義出該晶圓之切割道;

進行一非等向蝕刻製程,去除未被該光阻圖案覆蓋之該 晶圓,以形成複數個晶粒;以及 分離該黏著層與該支撐載具。

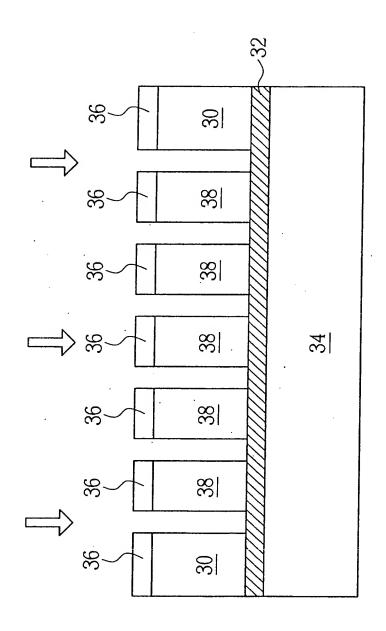
- 12.如申請專利範圍第 11 項所述之方法,其中該黏著層係 為一熱分離膠帶。
- 13.如申請專利範圍第 12 項所述之方法,其中分離該擴張 膜與該支撐載具係利用加熱方式達成。
- 14.如申請專利範圍第 13 項所述之方法,其中該擴張膜係 為一具擴張性之膠帶,且該膠帶之熔點大於該熱分離膠 帶之熔點。
- 15.如申請專利範圍第 11 項所述之方法,其中該黏著層係 為一紫外線膠。

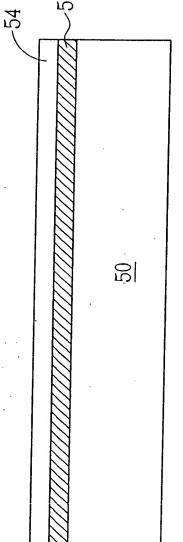
- 16.如申請專利範圍第15項所述之方法,其中分離該擴張 膜與該支撐載具係利用照射紫外線方式達成。
- 17.如申請專利範圍第 16 項所述之方法,其中該擴張膜係 為一具擴張性之膠帶。
- 18.如申請專利範圍第 11 項所述之方法,另包含於該非等向性蝕刻製程完成後進行一去除該光阻圖案之步驟。
- 19.如申請專利範圍第 11 項所述之方法,另包含於分離該擴張膜與該支撐載具後進行一擴片暨撿晶製程。

## 十一、圖式:



第1圖



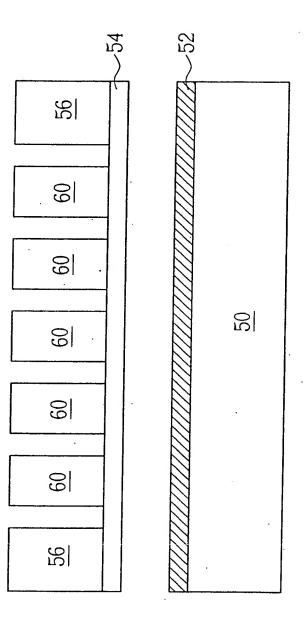


	55 C7	20 
26		50

第5圖

第6圖

{



ĺ

第8圖